

반도체재료 생산 대폭 증가

일본, 94년 31% 증가 348억엔 ... 휴대전화용 호조

일본의 GaAs(갈륨비소) 등 화합물 반도체재료의 94년 출하액이 31.0% 대폭 증가한 것으로 드러났다. 상반기에 23.0% 증가한 160억엔을 달성한 출하액은 하반기에 들어서 빠른 속도로 확대, 187억엔으로 39.0% 증가한 것으로 알려졌다.

구 분		일본의 화합물 반도체재료 출하현황 (단위 : 100만엔, %)							
		GaAs		Gap		InP 기타		합 계	
		출하액	증감률	출하액	증감률	출하액	증감률	출하액	증감률
1990	1~6	4,822	6	5,350	12	1,076	3	11,248	9
	7~12	6,124	30	5,764	30	1,075	▽4	12,963	26
	계	10,946	18	11,114	21	2,151	0	24,211	17
1991	1~6	6,059	26	5,981	12	991	▽8	13,031	16
	7~12	6,401	4	5,495	▽5	1,031	▽4	12,927	0
	계	12,460	14	11,476	3	2,002	▽6	25,958	7
1992	1~6	5,921	▽2	5,505	▽8	1,150	16	12,576	▽3
	7~12	5,444	▽15	5,285	▽4	980	▽5	11,709	▽9
	계	11,365	▽9	10,790	▽6	2,130	5	24,285	▽6
1993	1~6	5,707	▽4	6,484	18	852	▽26	13,043	4
	7~12	5,956	9	6,657	26	920	▽6	13,533	16
	계	11,663	3	13,141	22	1,772	▽17	26,576	9
1994	1~6	7,151	25	7,918	22	1,010	19	16,079	23
	7~12	9,009	51	8,569	29	1,209	31	18,787	39
	계	16,160	39	16,487	25	2,219	25	34,866	31

특히 GaAs는 휴대용전화용 MMIC, 반도체레이저(LD)용의 신장으로 하반기에 51% 증가한 90억엔을 기록했다. GaP (갈륨인)은 29% 증가한 85억엔으로 나타났다.

과거 최대의 신장률을 보인 GaAs는 이동체 통신용 디바이스의 호조에 따라 161억엔을 기록, 39% 큰폭 증가한 것으로 알려졌다.

GaP은 LED(발광다이오드)용이 여전히 활황세를 지속, 25% 증가한 164억엔을 나타냈다.

또한 InP(인듐인)은 주용도인 광통신용 등이 격증, 51% 증가한 18억엔을 확보, 인듐·안티몬 등 기타 타결정을 포함, 31% 증가한 34억엔으로 과거 최고를 기록했다.

<화학저널 1995/6/26>